

日程表 (会場別:N101~N321)

9月7日(日)・8日(月)

会場名	収容人数	2025年9月7日(日)		2025年9月8日(月)	
		午前	午後	午前	午後
N101	605		13:30 ~ 18:00 NT1【一般公開】社会を変えるワイドギャップ半導体材料の現状と将来		13:30 ~ 17:00 NT2【一般公開】才能が芽吹く大学入試へ：日本の科学技術と大学教育のこれから
N102	150		13:30 ~ 16:30 T11 ナノ荷電粒子ビーム技術の最先端	10:00 ~ 11:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 17:30 T2 脳の情報処理をめぐる数理・材料・生理の融合～ニューロモルフィックと神経機能の融合フロンティア～
N103	150	09:00 ~ 11:45 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	13:30 ~ 16:45 T6 ミューオンが拓く科学と技術		13:30 ~ 17:30 T25 光と熱の融合が拓く機能制御の最前線
N104	142		13:30 ~ 17:05 T9 ナノスケール計測技術の最前線～プローブ顕微鏡が拓く極微電子計測		13:30 ~ 17:05 T8 フォトニクスが拓く水の科学
N105	180	10:00 ~ 11:30 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 16:30 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	09:00 ~ 11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 15:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」
N106	154	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域	09:00 ~ 11:15 3.4 レーザー装置・材料	13:30 ~ 16:30 3.4 レーザー装置・材料
N107	154	09:45 ~ 12:00 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	14:00 ~ 16:00 ※有料※ チュートリアル「高温超伝導SQUIDの基礎と実用化」 田中 三郎 (豊橋技術科学大学)	10:00 ~ 12:00 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	13:30 ~ 16:00 ※有料※ チュートリアル「光を捉え、増幅する」 鈴木 健高/大橋 裕人 (浜松ホトニクス)
N201	250	09:15 ~ 12:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 17:00 9.1 誘電体材料、誘電体	09:00 ~ 11:30 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 17:15 9.5 新機能材料・新物性
N202	150	09:00 ~ 12:00 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 17:15 6.4 薄膜新材料	09:30 ~ 11:45 15.1 パルク結晶成長	13:30 ~ 18:15 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御
N203	150		13:30 ~ 18:15 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	10:00 ~ 12:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:30 ~ 17:15 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics
N204	142	09:00 ~ 12:00 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	13:30 ~ 16:15 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	10:00 ~ 11:15 CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション	13:30 ~ 18:30 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学
N205	180		13:30 ~ 16:45 CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション	09:00 ~ 12:00 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	13:30 ~ 15:00 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション
N206	154	09:00 ~ 12:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:30 ~ 16:15 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	09:00 ~ 12:15 6.6 プローブ顕微鏡	13:30 ~ 17:45 3.12 半導体光デバイス
N221	108	09:00 ~ 11:45 3.6 レーザープロセッシング	13:30 ~ 16:30 3.7 光計測技術・機器	09:00 ~ 12:15 3.6 レーザープロセッシング	13:30 ~ 17:15 3.10 フォトニック構造・現象
N301	250	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:45 15.4 III-V族窒化物結晶
N302	150	09:00 ~ 11:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 18:30 17.3 層状物質	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 18:45 17.3 層状物質
N303	150	09:00 ~ 12:15 KS4 量子エネルギー変換研究会	13:30 ~ 18:15 KS4 量子エネルギー変換研究会	09:00 ~ 11:15 10.5 磁場応用	13:30 ~ 17:45 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術
N304	142	10:00 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 18:00 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 16:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)
N305	180		13:30 ~ 18:30 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 09:45 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	13:30 ~ 18:30 12.7 医用工学・バイオチップ
N306	154	09:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 19:00 12.2 評価・基礎物性
N307	154	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	16:00 ~ 18:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 11:30 12.1 作製・構造制御	13:00 ~ 17:30 12.1 作製・構造制御
N321	192	09:30 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全般	13:30 ~ 17:45 3.8 テラヘルツ全般	09:30 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 18:45 6.2 カーボン系薄膜
N322	192	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 18:00 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	09:30 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 18:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価

共通講義棟北(N)

会場名	収容人数	2025年9月9日(火)		2025年9月10日(水)	
		午前	午後	午前	午後
N101	605		13:30 ~ 17:25 T24 【一般公開】先端ロジック半導体とその周辺技術		
N102	150	09:00 ~ 11:45 CS.4 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:45 T17 構造が誘起するスピントロニクス新物理現象		
N103	150	09:00 ~ 12:00 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	13:30 ~ 17:50 T13 軟X線多層膜が拓く短波長Beyond EUV/ソグラーフイー技術	09:30 ~ 12:00 T26 不規則・不均質材料の力学における材料横断的融合とその最前線	13:30 ~ 16:45 T26 不規則・不均質材料の力学における材料横断的融合とその最前線
N104	142	09:00 ~ 12:00 T4 微かな電気の検出が我々の世界を支える	13:30 ~ 15:30 T4 微かな電気の検出が我々の世界を支える	09:00 ~ 11:30 3.3 生体・医用光学	13:30 ~ 16:15 3.3 生体・医用光学
N105	180	09:00 ~ 11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:15 ~ 19:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 16:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
N106	154	09:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 16:15 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	09:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 16:15 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
N107	154	09:00 ~ 12:00 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 17:15 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 11:15 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術	13:30 ~ 16:00 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術
N201	250	09:00 ~ 11:30 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 17:15 6.1 強誘電体薄膜	09:00 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 15:30 9.4 熱電変換
N202	150	09:00 ~ 12:00 CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御のコードシェアセッション	13:30 ~ 18:15 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	09:30 ~ 11:30 3.9 光子量子物理・技術	13:00 ~ 15:15 3.9 光子量子物理・技術
N203	150	09:00 ~ 12:00 4.3 Laser sources and Laser applications	13:30 ~ 17:15 4.3 Laser sources and Laser applications	09:00 ~ 12:00 4.6 Terahertz Photonics	13:30 ~ 16:30 4.6 Terahertz Photonics
N204	142	09:30 ~ 11:45 4.6 Terahertz Photonics	13:30 ~ 18:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	09:00 ~ 11:45 9.3 ナノエレクトロニクス	13:30 ~ 16:15 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学
N205	180	09:00 ~ 11:30 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 15:30 13.8 光物性・発光デバイス	09:00 ~ 11:45 CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション	13:30 ~ 15:15 CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション
N206	154	09:30 ~ 12:15 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	13:30 ~ 17:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス
N221	108	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:30 3.10 フォトニック構造・現象	09:30 ~ 12:15 3.10 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 16:15 3.10 フォトニック構造・現象
N301	250	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 19:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 17:00 15.4 III-V族窒化物結晶
N302	150	09:00 ~ 12:00 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 15:00 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 16:30 13.5 デバイス/配線/集積化技術
N303	150	09:00 ~ 11:30 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:30 ~ 16:15 KS.1 固体量子センサ研究会	09:00 ~ 12:00 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	13:30 ~ 16:00 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス
N304	142	09:00 ~ 11:45 KS.2 量子情報工学研究会	13:30 ~ 17:45 KS.2 量子情報工学研究会	10:00 ~ 11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 15:15 16.3 シリコン系太陽電池
N305	180	09:00 ~ 12:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 17:30 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	09:00 ~ 12:00 CS.11 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション	13:30 ~ 16:45 12.7 医用工学・バイオチップ
N306	154	09:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 16:45 3.6 レーザープロセス		
N307	154	09:00 ~ 12:00 CS.10 6.6 フロー顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:30 6.6 フロー顕微鏡		
N321	192	09:00 ~ 12:30 KS4 量子エネルギー変換研究会	13:30 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス
N322	192	10:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 19:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価		13:30 ~ 17:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)

会場名	収容人数	2025年9月7日(日)		2025年9月8日(月)		
		午前	午後	午前	午後	
共通講義棟北 (N)	N323	192	09:00 ~ 11:45 8.4 プラズマライブサイエンス	13:30 ~ 16:30 8.4 プラズマライブサイエンス	09:00 ~ 12:15 KS4 量子エネルギー変換研究会	
	N324	192			09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 17:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術
	N401	108		13:30 ~ 18:15 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	09:30 ~ 12:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	14:00 ~ 17:00 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶
	N402	108			09:00 ~ 12:15 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 18:00 3.7 光計測技術・機器のコードシェアセッション
	N403	108	09:30 ~ 12:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 16:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 11:45 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:30 ~ 17:45 CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション
	N404	108			09:00 ~ 12:00 11.1 基礎物性	13:30 ~ 18:00 11.1 基礎物性
	N405	108	09:30 ~ 11:15 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 17:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	09:00 ~ 12:00 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 18:30 3.5 超高速・高強度レーザー
N406	108		13:00 ~ 16:15 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	10:45 ~ 11:30 1.1 応用物理一般・学際領域	16:00 ~ 17:15 1.2 教育	
共通講義棟南 (S)	S101	510				13:30 ~ 17:30 NT3【一般公開】Z世代に繋ぎたい宇宙x半導体の未来ビジョン ~ 創造を生むネットワークを応用から
	S102	341	10:00 ~ 11:20 T23 ペロブスカイト・化合物・シリコン ~ タンデム型太陽電池の現状と将来展望~	13:00 ~ 16:15 T23 ペロブスカイト・化合物・シリコン ~ タンデム型太陽電池の現状と将来展望~		13:00 ~ 18:00 T1 日韓共同応用物理シンポジウム「量子材料・デバイスと先端半導体」
	S103	341	10:00 ~ 12:05 T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術 (2)	13:30 ~ 17:15 T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術 (2)	09:00 ~ 12:00 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 18:00 T14 プラズマ触媒反応が拓く革新的物質変換技術
	S201	398		13:00 ~ 18:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	10:00 ~ 11:40 T18 フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスの特長と応用	13:30 ~ 17:25 T18 フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスの特長と応用
	S202	228	11:00 ~ 12:00 功労会員証贈呈式、フェロ表彰式、講演奨励賞授賞式	13:00 ~ 16:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	09:00 ~ 11:45 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:30 ~ 18:25 T3 Lab to Fab: 研究開発と量産を最速でつなぐ半導体DX
	S203	228		13:00 ~ 16:30 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料 16:45 ~ 17:45 17.2 グラフェン		13:30 ~ 18:15 T19 ナノバイオテクノロジー分野における実験と分子シミュレーションのインタープレイ
S301	304		13:30 ~ 17:00 T7 最先端光科学が拓く地球型系外惑星探査		13:30 ~ 17:10 T10 表面・界面の反応/成長制御による高機能性材料の創製	
S302	273				13:30 ~ 17:30 T12 幅広い波長域の光を駆使する研究の最前線-X線からテラヘルツまで-	
体育館 (P)			09:30-11:30 7 ビーム応用 15.1 バルク結晶成長 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 17 ナノカーボン・二次元材料	13:30-15:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 プラズマナノテクノロジー 10 スピントロニクス・マグネティクス 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:30-11:30 3.1 光学基礎・光学新領域 3.8 テラヘルツ全般 3.10 フォトニック構造・現象 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御 6.4 薄膜新材料 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.5 デバイス/配線/集積化技術 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30-15:30 1 応用物理学一般 6.6 プロープ顕微鏡 13.3 絶縁膜技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.9 化合物太陽電池
			16:00-18:00 3.4 レーザー装置・材料 3.6 レーザープロセス 11 超伝導 12.1 作製・構造制御 12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	16:00-18:00 3.2 情報フォトニクス・画像工学 4.3 Laser sources and Laser applications 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics 6.1 強誘電体薄膜 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」 KS4 量子エネルギー変換研究会		

会場名	収容人数	2025年9月9日(火)		2025年9月10日(水)	
		午前	午後	午前	午後
N323	192	09:30 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 16:30 13.9 化合物太陽電池	09:00 ~ 12:00 8.1 プラズマ生成・診断	13:30 ~ 17:00 8.1 プラズマ生成・診断
N324	192	09:00 ~ 10:00 8.3 プラズマナノテクノロジー 10:15 ~ 10:45 8.8 プラズマエレクトロニクス受賞記念講演	13:30 ~ 18:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	09:00 ~ 12:00 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	13:30 ~ 16:45 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理
N401	108	09:00 ~ 12:00 CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:30 CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	09:00 ~ 11:15 13.3 絶縁膜技術	13:30 ~ 15:15 13.3 絶縁膜技術
N402	108	10:00 ~ 12:00 3.7 光計測技術・機器	16:00 ~ 17:45 3.7 光計測技術・機器	09:00 ~ 12:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 16:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎
N403	108	09:00 ~ 12:00 7.2 電子ビーム応用	13:30 ~ 17:45 7.2 電子ビーム応用	09:15 ~ 12:00 7.1 X線技術	13:30 ~ 16:30 7.3 微細パターン・微細構造形成技術
N404	108	09:30 ~ 11:00 11.1 基礎物性	13:30 ~ 17:45 11.4 アナログ応用および関連技術	09:30 ~ 11:45 11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	
N405	108	09:00 ~ 10:30 16.2 エナジーハーベスティング	13:30 ~ 18:30 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	09:30 ~ 11:45 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	
N406	108	10:00 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:00 ~ 16:30 1.6 超音波		13:00 ~ 15:30 1.5 計測技術・計測標準
S101	510	10:00 ~ 11:45 NT4【一般公開】就活生必見！次世代を担う頭脳ー半導体産業の最前線ー	13:30 ~ 15:40 NT4【一般公開】就活生必見！次世代を担う頭脳ー半導体産業の最前線ー	10:00 ~ 12:00 ※有料※ チュートリアル「インフォマティクス応用入門Ⅱ 体験編」 杏掛 健太郎 (名古屋大学)	13:00 ~ 17:00 T28 インフォマティクス応用の未来を切り拓くー世界動向、分野間連携、そして新たな挑戦ー
S102	341	09:00 ~ 11:30 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:00 ~ 17:15 T27 二次元物質量子エレクトロニクス	09:00 ~ 11:30 17.3 層状物質	13:00 ~ 15:30 17.3 層状物質
S103	341	09:00 ~ 11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:00 T16 熱流れの中で発電する新しい熱エネルギー変換について語る	09:00 ~ 11:30 17.2 グラフェン	
S201	398	10:00 ~ 12:00 ※有料※ チュートリアル「いまさら聞けない有機薄膜太陽電池の基礎：変換効率25%は原理的に達成可能か？」 大北 英生(京都大学)	13:30 ~ 17:20 T20 最先端デバイスへつなぐ有機作製技術と構造制御	09:00 ~ 11:45 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 16:15 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
S202	228	09:30 ~ 12:00 NT5【一般公開】学術会議に適したMICE施設とは？ーMICEインフラを考えるー	13:30 ~ 18:30 T5 水電解および二酸化炭素還元デバイスとシステムの現状		
S203	228	09:00 ~ 11:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:35 T21 宇宙開発を支えるバイオデバイス科学の最前線		
S301	304	09:30 ~ 11:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 16:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」		
S302	273	09:00 ~ 12:30 T22 外界からの刺激作用による細胞制御：刺激作用の伝達から制御効果の発現までを理解する	16:00 ~ 17:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		
		09:30-11:30 6.2 カーボン系薄膜 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.5 表面物理・真空 9 応用物性 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 KS.1 固体量子センサ研究会	13:30-15:30 3.3 生体・医用光学 3.5 超高速・高強度レーザー 3.7 光計測技術・機器 3.9 光子物理・技術 3.12 半導体光デバイス 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	09:30-11:30 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 12.2 評価・基礎物性 12.4 有機EL・トランジスタ 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.4 III-V族窒化物結晶	
			16:00-18:00 2 放射線 8.1 プラズマ生成・診断 8.4 プラズマライファイエンス 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 13.8 光物性・発光デバイス 15.6 IV族系化合物 (SiC) 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥 16 非晶質・微結晶		